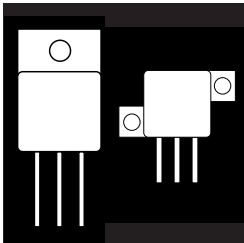


POWER MOSFETS IN HERMETIC ISOLATED JEDEC TO-254AA SIZE 6 DIE



400V, 500V, N-Channel, Up To 24 Amp
Size 6 MOSFETs, High Energy Capability

FEATURES

- Isolated Hermetic Metal Package
- Size 6 Die, High Energy
- Fast Switching, Low Drive Current
- Ease of Paralleling For Added Power
- Low $R_{DS(on)}$
- Available Screened To MIL-S-19500, TX, TXV And S Levels

DESCRIPTION

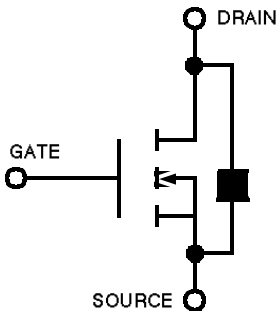
This series of hermetically packaged products feature the latest advanced MOSFET and packaging technology. They are ideally suited for Military requirements where small size, high performance and high reliability are required, and in applications such as switching power supplies, motor controls, inverters, choppers, audio amplifiers and high energy pulse circuits. This series also features avalanche high energy capability at elevated temperatures.

MAXIMUM RATINGS

PART NUMBER	V_{DS}	$R_{DS(on)}$	I_D (Amp)
OM6025SA	400	.23	24
OM6026SA	500	.30	22

3.1

SCHEMATIC



OM6025SA - OM6026SA

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

	Parameter	OM6025SA	OM6026SA	Units
V_{DS}	Drain-Source Voltage	400	500	V
V_{DGR}	Drain-Gate Voltage ($R_{GS} = 1\text{ M } \Omega$)	400	500	V
$I_D @ T_C = 25^\circ\text{C}$	Continuous Drain Current ²	24	22	A
I_{DM}	Pulsed Drain Current ²	92	85	A
$P_D @ T_C = 25^\circ\text{C}$	Maximum Power Dissipation	165	165	W
	Derate Above 25°C Ambient	.025	.025	W/ $^\circ\text{C}$
$W_{DSS} (1) (2)$	Single Pulse Energy Drain To Source @ 25°C	1000	1200	mJ
T_J	Operating and			
T_{stg}	Storage Temperature Range	-55 to 150	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
Lead Temperature	(1/8" from case for 5 secs.)	275	275	$^\circ\text{C}$

Note 1: $V_{DD} = 50\text{V}$, $I_D = \text{as noted}$

Note 2: Package Pin Limitation $I_D @ T_C = 25^\circ\text{C} = 25\text{ Amps}$

THERMAL RESISTANCE (MAXIMUM) at $T_A = 25^\circ\text{C}$

R_{thJC}	Junction-to-Case	.76	$^\circ\text{C/W}$	
R_{thJA}	Junction-to-Ambient	40	$^\circ\text{C/W}$	Free Air Operation
	Derate Above 25°C Case	1.32	W/ $^\circ\text{C}$	

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: OM6026SA (T_C = 25° unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
OFF CHARACTERISTICS					
Drain-Source Breakdown Voltage (V _{GS} = 0, I _D = 0.25 mA)	V _{DSS}	500	-	-	Vdc
Zero Gate Voltage Drain (V _{DS} = 500 V, V _{GS} = 0)	I _{DSS}	-	-	0.25	mAdc
(V _{DS} = 500 V, V _{GS} = 0, T _J = 125° C)		-	-	1.0	
Gate-Body Leakage Current, Forward (V _{GSF} = 20 Vdc, V _{DS} = 0)	I _{GSSF}	-	-	100	nAdc
Gate-Body Leakage Current, Reverse (V _{GSR} = 20 Vdc, V _{DS} = 0)	I _{GSSR}	-	-	100	nAdc

ON CHARACTERISTICS*

Gate-Threshold Voltage (V _{DS} = V _{GS} , I _D = 0.25 mAdc (T _J = 125° C)	V _{GS(th)}	2.0 1.5	3.0 -	4.0 3.5	Vdc
Static Drain-Source On-Resistance (V _{GS} = 10 Vdc, I _D = 11 Adc)	r _{DS(on)}	-	-	0.30	Ohm
Drain-Source On-Voltage (V _{GS} = 10 Vdc)	V _{DS(on)}	-	-	8.0	Vdc
(I _D = 22 A)		-	-	8.0	
(I _D = 11 A, T _J = 125° C)		-	-	-	
Forward Transconductance (V _{DS} = 15 Vdc, I _D = 11 Adc)	g _{FS}	11	-	-	mhos

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Input Capacitance (V _{DS} = 25 V, V _{GS} = 0, f = 1.0 MHz)	C _{iss}	-	5600	-	pF
Output Capacitance	C _{oss}	-	680	-	
Transfer Capacitance	C _{rss}	-	200	-	

SWITCHING CHARACTERISTICS

Turn-On Delay Time (V _{DD} = 250 V, I _D = 22 A, R _{gth} = 4.3 ohms)	t _{d(on)}	-	70	-	ns
Rise Time	t _r	-	190	-	
Turn-Off Delay Time	t _{d(off)}	-	160	-	
Fall Time	t _f	-	160	-	
Total Gate Charge (V _{DS} = 400 V, I _D = 22 A, V _{GS} = 10 V)	Q _g	-	115	140	nC
Gate-Source Charge	Q _{gs}	-	20	-	
Gate-Drain Charge	Q _{gd}	-	60	-	

SOURCE DRAIN DIODE CHARACTERISTICS

Forward On-Voltage (I _S = 22 A, dI/dt = 100 A/μs)	V _{SD}	-	1.1	1.6	Vdc
Forward Turn-On Time	t _{on}	-	**	-	ns
Reverse Recovery Time	t _{rr}	-	500	1000	

* Indicates Pulse Test = 300 μsec, Duty Cycle = 2%

** Limited by circuit inductance

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: OM6025SA (T_C = 25° unless otherwise noted)

Drain-Source Breakdown Voltage (V _{GS} = 0, I _D = 0.25 mA)	V _{DSS}	400	-	-	Vdc
Zero Gate Voltage Drain (V _{DS} = 400 V, V _{GS} = 0)	I _{DSS}	-	-	0.25	mAdc
(V _{DS} = 400 V, V _{GS} = 0, T _J = 125° C)		-	-	1.0	
Gate-Body Leakage Current, Forward (V _{GSF} = 20 Vdc, V _{DS} = 0)	I _{GSSF}	-	-	100	nAdc
Gate-Body Leakage Current, Reverse (V _{GSR} = 20 Vdc, V _{DS} = 0)	I _{GSSR}	-	-	100	nAdc

ON CHARACTERISTICS*

Gate-Threshold Voltage (V _{DS} = V _{GS} , I _D = 0.25 mAdc (T _J = 125° C)	V _{GS(th)}	2.0 1.5	3.0 -	4.0 3.5	Vdc
Static Drain-Source On-Resistance (V _{GS} = 10 Vdc, I _D = 12 Adc)	r _{DS(on)}	-	-	0.23	Ohm
Drain-Source On-Voltage (V _{GS} = 10 Vdc)	V _{DS(on)}	-	-	5.6	Vdc
(I _D = 24 A)		-	-	5.6	
(I _D = 12 A, T _J = 125° C)		-	-	-	
Forward Transconductance (V _{DS} = 15 Vdc, I _D = 12 Adc)	g _{FS}	14	-	-	mhos

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Input Capacitance (V _{DS} = 25 V, V _{GS} = 0, f = 1.0 MHz)	C _{iss}	-	5600	-	pF
Output Capacitance	C _{oss}	-	78	-	
Transfer Capacitance	C _{rss}	-	230	-	

SWITCHING CHARACTERISTICS

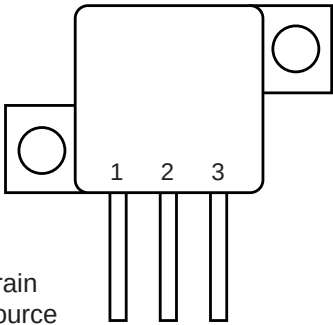
Turn-On Delay Time (V _{DD} = 250 V, I _D = 24 A, R _{gth} = 4.3 ohms)	t _{d(on)}	-	70	-	ns
Rise Time	t _r	-	190	-	
Turn-Off Delay Time	t _{d(off)}	-	160	-	
Fall Time	t _f	-	160	-	
Total Gate Charge (V _{DS} = 400 V, I _D = 24 A, V _{GS} = 10 V)	Q _g	-	110	140	nC
Gate-Source Charge	Q _{gs}	-	20	-	
Gate-Drain Charge	Q _{gd}	-	55	-	

SOURCE DRAIN DIODE CHARACTERISTICS

Forward On-Voltage (I _S = 24 A, dI/dt = 100 A/μs)	V _{SD}	-	1.1	1.6	Vdc
Forward Turn-On Time	t _{on}	-	**	-	ns
Reverse Recovery Time	t _{rr}	-	500	1000	

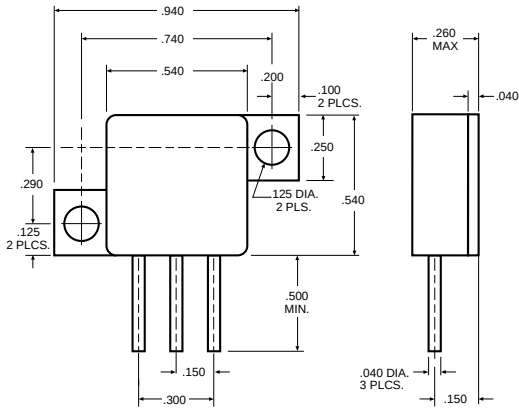
OM6025SC - OM6026SC

PIN CONNECTION

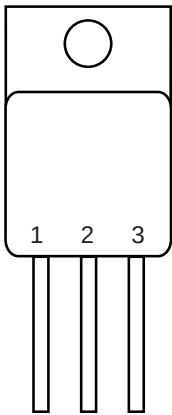


Pin 1: Drain
Pin 2: Source
Pin 3: Gate

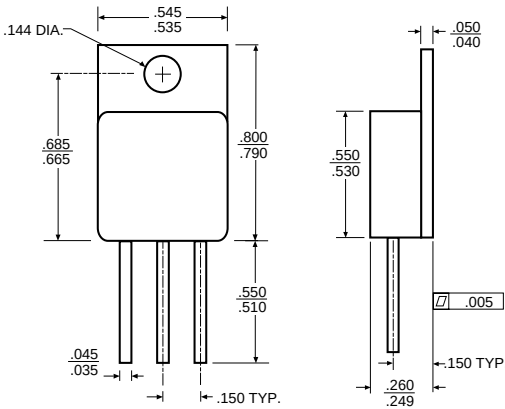
MECHANICAL OUTLINE



M-3S

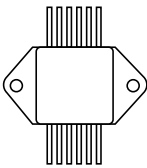


Pin 1: Drain
Pin 2: Source
Pin 3: Gate

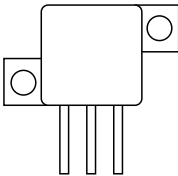


M-PAK

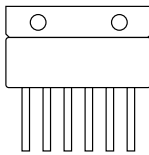
PACKAGE OPTIONS



MOD PAK



Z-TAB



6 PIN SIP

- NOTES:**
- Standard Products are supplied with glass feedthroughs. For ceramic feedthroughs, add the letter "C" to the part number. Example - OMXXXXCSA.
 - MOSFETs are also available in Z-Tab, dual and quad pak styles - Please call the factory for more information.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.